

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年6月5日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”的议案》和《关于使用部分超募资金实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”的议案》，同意使用超募资金9,547万元在昆明新城高新技术产业基地B-5-5 地块云南国家锗材料基地内实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”。

详细内容请见公司于2012年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”的公告》。

2013年8月27日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”暨变更项目实施主体的议案》，同意公司变更“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施主体，并同意公司使用超募资金6683万元设立控股子公司云南鑫圆新材料有限责任公司（暂定名，实际工商登记名称为：云南鑫耀半导体材料有限公司）负责实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”。

详细内容请见公司于2013年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于使用部分超募资金设立控股子公司实施“砷化镓单晶材料产业化建设项目”暨变更项目实施主体的公告》。

2016年3月29日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加投资的议案》，同意调整“砷化镓单晶材料产业化建设项目”实施内容并增加投资1585.24万元。

一、原项目建设内容如下：

1、建设内容

本项目将建设一条年产Φ2"砷化镓（GaAs）抛光晶片80万片的单晶材料生产线及与其相适应的生产厂房、办公用房和其他配套设施。

项目总投资9,547万元，其中固定资产投资8,686万元，流动资金861万元，新建建筑面积6,647 m²，购置设备仪器228台（套）。项目建成后，将实现开盒即用Φ2"砷化镓抛光晶片80万片/年（对应的单晶材料6373公斤/年）的生产能力。

2、项目预算

本项目总投资9,547万元，其中固定资产投资8,686万元，流动资金861万元。

其中，固定资产投资估算为8,686万元，估算范围包括工艺设备购置及安装费、动力设备购置及安装费、建筑工程费、工程建设其他费用、预备费等。

3、实施主体

本项目实施主体为公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）。鑫耀公司基本情况如下：

公司名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

住所：昆明市高新区电子工业标准厂房A栋1楼

注册号：530100100354474

注册资本：玖仟伍佰肆拾柒万元正

实收资本：陆仟玖佰捌拾叁万元正

公司类型：非自然人出资有限责任公司

法定代表人姓名：李苏滨

经营范围：高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学锗镜头及元件、红外成像设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询；自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；计算机软件的开发及技术咨询；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：二〇一三年九月十日

4、项目建设的资金来源

本项目总投资 9,547 万元，全部为鑫耀公司自有资金。

二、此次调整项目实施内容的原因及主要内容

为丰富产品种类、规格，增加了部分设备投资，原项目规划建设一条年产 $\Phi 2''$ 砷化镓（GaAs）抛光晶片 80 万片的单晶材料生产线，项目调整后，具备了 $\Phi 4''$ 砷化镓抛光晶片生产能力，同时新增机器设备使得产能增加，原项目产能为 $\Phi 2''$ 砷化镓（GaAs）抛光晶片 80 万片/年，现调整为： $\Phi 2''$ 砷化镓（GaAs）抛光晶片 120 万片/年或 $\Phi 4''$ 砷化镓（GaAs）抛光晶片 80 万片/年；其次，为适应今后不断提高的环保要求，调整增加了“废水处理回用系统”，实现“含重金属废水”零排放；再次，为保障项目生产的稳定运行，公司在环保设施试运行期间，采取了积极稳妥的安全措施，在保证废水不外排的前提下，导致试车运行费用增加。

此次调整新增单面抛光机 1 台、双面抛光机 1 台、 $\Phi 2''$ 砷化镓单晶炉 6 台，其它设备差价共计新增 769.05 万元；“废水处理回用系统”增加投资 315 万元；试车运行费用增加 501.19 万元。综上所述，此次项目实施内容调整，共计增加投资 1585.24 万元。

三、此次追加投资后项目建设的主要内容

1、建设内容

本项目将建设一条年产Φ2" 砷化镓（GaAs）抛光晶片 120 万片（Φ4" 砷化镓（GaAs）抛光晶片 80 万片）的单晶材料生产线及与其相适应的生产厂房、办公用房和其他配套设施。

2、项目投资

本项目调整后总投资 11,132.24 万元，包括建筑工程、设备购置、安装工程、其他费用等。

四、资金来源

此次用于追加项目投资的资金 1585.24 万元将全部来源于控股子公司鑫耀公司的自有资金。

五、项目实施内容调整的影响

此次项目实施内容调整主要是实施过程中增加产品种类、规格，导致设备增加，其次是增加了环保方面的投入，再次试运行期间费用增加。此次调整，有利于丰富项目产品种类、规格，增强运营后的市场竞争力，同时对环保系统进行改造，有利于提高项目环保水平。

砷化镓是微电子和光电子的基础材料，在超高速、超高频、低功耗、低噪声器件和电路，特别在光电子器件和光电集成方面占有独特的优势；同时半导体砷化镓材料广泛用于研制可见光激光器、半导体大功率激光器、发光二极管和太阳能电池等领域。项目的建设将对公司产业链延伸起到积极作用，公司建设自己的砷化镓晶体生产线有利于今后产业链的延伸和完善。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016年03月31日